

Выписка из протокола № 1
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук
27 января 2020 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН - С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН - Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН - Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов
	- доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» - Ю.В. Колковский
	- член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев
	- главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня:

2. Проведение конкурса на замещение вакантной должности заведующего лабораторией № 101 «Лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений A_3B_5 ».

Докладчик: С.А. Гамкрелидзе.

Слушали:

По 2-му пункту повестки дня:

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Климова Евгения Александровича для избрания его на должность заведующего лабораторией № 101 «Лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений A_3B_5 ».

Директор зачитал характеристику Е.А. Климова, подписанную заместителем директора по научной работе Д.С. Пономаревым в ней, в частности отмечается, что Климов Е.А. в совершенстве освоил технологию роста и исследования электрофизических параметров приборных структур на подложках GaAs и InP, таких как: НЕМТ и РНЕМТ (как односторонне легированные для МШУ, так и с двухсторонним легированием для мощных СВЧ транзисторов). Им также освоена технология роста и исследования метаморфных и низкотемпературных структур на подложках GaAs и InP с различными кристаллографическими ориентациями поверхности.

Климов Е.А. участвовал в выполнении научно-исследовательских работ ИСВЧПЭ РАН, в том числе в должности ответственного исполнителя и заместителя руководителя темы, финансируемых как из государственного бюджета, так и из бюджета МО РФ, посвященных разработке современной гетероструктурной элементной базы СВЧ – электроники; являлся исполнителем при выполнении проектов по Программам фундаментальных исследований Президиума РАН и грантов Российского фонда фундаментальных исследований. Климов Е.А. являлся руководителем проекта при поддержке «Российского фонда фундаментальных исследований» и проекта поддержанного «Фондом поддержки образования и науки имени члена-корреспондента РАН Мокерова В.Г.». В 2017 году Климов Е.А. был награжден Почетной грамотой Российской академии наук «За добросовестный и плодотворный труд на благо отечественной науки, высокий профессионализм и в связи с 15-летием ФГБУН ИСВЧПЭ РАН» и Почетной грамотой Фонда поддержки образования и науки имени члена-корреспондента РАН Мокерова В.Г. «За длительное и активное участие в работах, направленных на создание отечественной компонентной базы в области СВЧ электроники и направленных на благо развития науки».

Климов Е.А. является соавтором 80 статей в рецензируемых отечественных и зарубежных научных журналах, входящих в перечень ВАК министерства образования и науки РФ, 42 статей в трудах конференций, 92 тезисов конференций, 10 патентов на изобретение и 3 монографий.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 2-му пункту повестки дня:

Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

Признать конкурс на замещение вакантной должности заведующего лабораторией № 101 «Лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ5» состоявшимся в объявленные сроки.

Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- заведующего лабораторией № 101 «Лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных электронных систем в наногетероструктурах соединений АЗВ5».

– Климова Евгения Александровича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор

Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«27» января 2020 г.



С.А. Гамквелидзе

Р.А. Хабибуллин